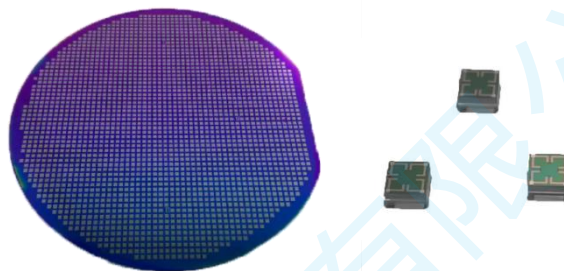


SOI 系列硅压阻式压力敏感芯片

产品特点

- CAD 设计、微电子与微机械融合工艺
- 顶层硅电阻条替代体硅扩散电阻
- 绝缘介质替代“PN 结”，消除反向漏电
- 高精度、稳定性好、使用温度范围宽
- 覆盖低、中、高压力量程范围



主要技术指标

- 基准量程：
100kPa、200kPa、400kPa、500kPa、700kPa、1MPa、1.6MPa、2MPa、2.5MPa、3.5MPa、10MPa、20MPa、30MPa、40MPa
- 感压形式：绝压（A）、密封表压（S）、表压（G）
- 芯片面积尺寸（ μm ）：
2400 \times 2400；2200 \times 2200
注：10MPa、20MPa、30MPa、40MPa 量程芯片尺寸为 2200 \times 2200，
其余规格芯片尺寸均为 2400 \times 2400
- 过载能力：大于 2 倍基准量程
- 桥路电阻：4（ $1\pm 20\%$ ）k Ω ；5（ $1\pm 20\%$ ）k Ω
- 零点输出： $\leq 30\text{mV}$
- 满量程输出：100 $\pm 20\text{mV}$
- 线性度： $\pm 0.2\% \text{F.S}$
- 零点热漂移： $\pm 0.15\% \text{F.S}/^\circ\text{C}$
- 热灵敏度漂移： $\pm 0.15\% \text{F.S}/^\circ\text{C}$
- 零点长期稳定性： $\leq \pm 0.05\% \text{F.S}/\text{年}$
- 供电电源：恒流 1.5mA
- 工作温度： $-55^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$ （铝电极焊盘）；
 $-55^\circ\text{C} \sim +300^\circ\text{C}$ （采用高温多层金属电极）

产品概述

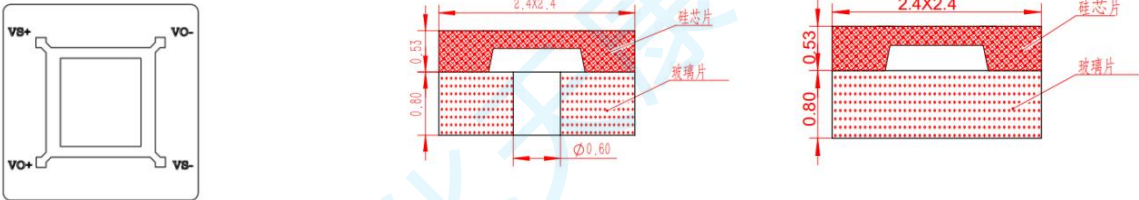
SOI 硅压阻式压力敏感芯片是用来制作 SOI 高温压力传感器的核心元件，该新型的半导体高温压力传感器具有耐高温、抗辐射和稳定性好等优点，能够解决石油、汽车、航空和航天等领域对高温压力传感器的迫切需求，在高温领域有很大的潜力。

型号及规格代号

ZKCS-X-XXX-SOI 系列硅压阻压力敏感芯片		
	代号	品种
	A	绝压
	S	密封表压
	G	表压
	代号	量程
	101	0~100kPa
	201	0~200kPa
	401	0~400kPa
	501	0~500kPa
	701	0~700kPa
	102	0~1MPa
	162	0~1.6MPa
	202	0~2MPa
	252	0~2.5MPa
	352	0~3.5MPa
	103	0~10MPa
	203	0~20MPa
	303	0~30MPa
	403	0~40MPa

ZK	C	S	-X	-XXX	(完整的规格型号)
				量程	
				A: 绝压, S: 密封表压, G: 表压	
				SOI 隔离	
				芯片	
				压力	

尺寸和焊接点示意图



注：此图片无法作为焊接图使用